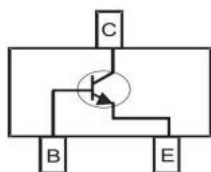
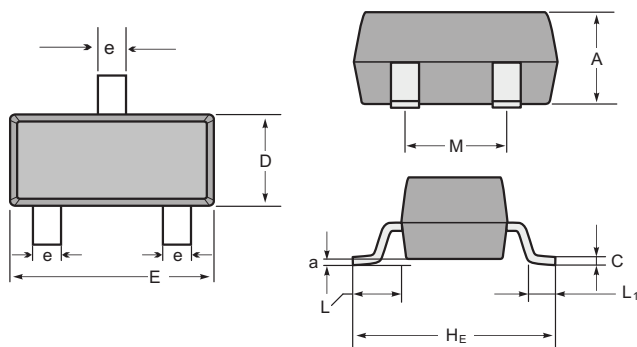


Features

NPN High Frequency



SOT-23



SOT-23 mechanical data

UNIT		A	C	D	E	H _E	e	M	L	L ₁	a
mm	max	1.1	0.15	1.4	3.0	2.6	0.5	1.95	0.55 (ref)	0.36 (ref)	0.0
	min	0.9	0.08	1.2	2.8	2.2	0.3	1.7			0.15
mil	max	43	6	55	118	102	20	77	22 (ref)	14 (ref)	0.0
	min	35	3	47	110	87	12	67			6

Absolute Maximum Rating (T_a=25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V _{CBO}	30	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V _{CEO}	25	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V _{EBO}	3	V
Collector Current 集电极电流	I _C	50	mA
Power dissipation 耗散功率	P _C (T _a =25°C)	225	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	R _{θJA}	556	°C/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T _J , T _{stg}	-55to+150°C	

MMBTH10

Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压 ($I_C=100\mu A$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	30	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压 ($I_C=1mA$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	25	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压 ($I_E=10\mu A$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	3	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流 ($V_{CB}=25V$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	100	nA
Collector-Emitter Leakage Current 集电极发射极漏电流 ($V_{CE}=20V$, $I_E=0$)	I_{CEO}	—	—	100	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流 ($V_{EB}=2V$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	100	nA
DC Current Gain 直流电流增益 ($V_{CE}=10V$, $I_C=4mA$)	H_{FE}	100	—	200	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降 ($I_C=4mA$, $I_B=0.4mA$)	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极导通压降 ($V_{CE}=10V$, $I_C=4mA$)	$V_{BE(on)}$	—	—	0.95	V
Transition Frequency 特征频率 ($V_{CE}=10V$, $I_C=4mA$)	f_T	650	—	—	MHz
Output Capacitance 输出电容 ($V_{CB}=10V$, $I_E=0$, $f=1MHz$)	C_{ob}	—	—	0.7	pF

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (MMBTH10)

